

Сведения о ведущей организации

Полное и сокращенное наименование	Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Пульсар»
Место нахождения	105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27
Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта	105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27; Телефон: +7(495) 365-12-30 Электронный адрес: administrator@pulsarnpp.ru
Список основных публикаций ведущих сотрудников организации по теме диссертации в журналах из списка ВАК за последние 5 лет:	<ol style="list-style-type: none"> 1. СПОСОБ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ ЗОЛОТОМ КОРПУСОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ/Сидоров В.А., Чупрунов А.Г., Гришаева А.С., Сидоров К.В.//Патент на изобретение RU 2815518 С1, 18.03.2024. Заявка от 23.08.2023. 2. ВЛИЯНИЕ МОДУЛЯЦИИ НА АМПЛИТУДНО-ФАЗОВУЮ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ СВЧ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ /Емельянов Б.В., Емельянов В.А.//В сборнике: Проблемы и перспективы развития энергетики, электротехники и энергоэффективности. материалы VI Международной научно-технической конференции. Чебоксары, 2022. С. 175-183. 3. КРИСТАЛЛ МОЩНОГО КРЕМНИЕВОГО СВЧ LDMOS-ТРАНЗИСТОРА С РАБОЧЕЙ ЧАСТОТОЙ ДО 2 ГГц/Бычков С.С., Романовский С.М.//Топология интегральной микросхемы RU 2022630104, 27.07.2022 4. GAAS ГЕТЕРОСТРУКТУРНЫЙ БИПОЛЯРНЫЙ СВЧ ТРАНЗИСТОР С КОЭФФИЦИЕНТОМ ШУМА 2 ДБ И ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕЙ ЛИНЕЙНОСТИ ПО ВЫХОДУ 18 ДБМ/Зайцев А.А., Вагин А.В., Кузьмин А.Ю., Пяткин А.М.//Топология интегральной микросхемы RU 2022630167, 12.10.2022 5. ПОДСИСТЕМА ТСАД- И SPICE-МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕМНИЕВЫХ БИС С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, РАДИАЦИИ И СТАРЕНИЯ/Петросянц К.О., Исмаил-заде М.Р., Кожухов М.В., Попов Д.А., Пугачёв А.А., Самбурский Л.М., Силкин Д.С., Харитонов И.А.//Наноиндустрия. 2022. Т. 15. № S8-1 (113). С. 183-19 6. ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ СЛОВЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА УСТАНОВКЕ LEI-1610/Кошкин А.В., Миннебаев С.В., Сейдман Л.А.//Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы. 2022. № 1 (264). С. 30-36 7. ТЕПЛОВОЙ АНАЛИЗ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ. СРАВНЕНИЕ ДВУХ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТИ/Евдокимова Н.Л., Долгов В.В.//Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы. 2022. № 1 (264). С. 37-47 8. ВЛИЯНИЕ ЛОВУШЕК НА МОРФОЛОГИЮ ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ НЕМТ НА ОСНОВЕ ALXGA1XN/GAN/ALYGA1YN/Максимов А.Н.//Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы. 2022. № 4 (267). С. 10-19 9. РАЗРАБОТКА И ОСВОЕНИЕ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА БИПОЛЯРНОГО МАЛОШУМЯЩЕГО ТРАНЗИСТОРА С КОЭФФИЦИЕНТОМ ШУМА 2 ДБ И ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕЙ ЛИНЕЙНОСТИ ПО ВЫХОДУ 18 ДБМ/Кузьмин А.Ю., Дрозденко Е.С., Чупрунов А.Г., Рахманов Ш.Т., Филатов Д.О., Огурцова К.М.//Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы. 2022. № 4 (267). С. 42-53.

	<p>10. ПРОГРАММА ТРЁХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСЧЁТА ТЕПЛООВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАНАРНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ БЫСТРОГО ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ (FOURIERHEAT3D)/Аболдуев И.М., Иванов К.А., Редька Ал.В., Василевский А.А., Золотарев А.А.//Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы. 2021. № 3 (262). С. 61-80.</p> <p>11. ВОЗМОЖНОСТИ LDMOS ТРАНЗИСТОРОВ, РАЗРАБОТАННЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ В S-ДИАПАЗОНЕ В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КВАЗИЛИНЕЙНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ/Аронов В.Л., Романовский С.М., Бычков С.С., Корнеев С.В., Крымко М.М.//Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы. 2019. № 4 (255). С. 4-9.</p> <p>12. УСИЛИТЕЛЬНЫЙ КАСКАД НА МОЩНОМ МНОГОКРИСТАЛЬНОМ ШИРОКОПОЛОСНОМ LDMOS ТРАНЗИСТОРЕ S-ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ/Романовский С.М.//диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет». 2018</p> <p>13. АНАЛИЗ ПОБОЧНЫХ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ СЛОЖЕНИИ ТРЁХ МОЩНЫХ КРИСТАЛЛОВ LDMOS ТРАНЗИСТОРОВ В ОДНОМ КОРПУСЕ/Романовский С.М.//Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы. 2018. № 3 (250). С. 44-52</p> <p>14. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОЩНЫХ КРЕМНИЕВЫХ СВЧ LDMOS ТРАНЗИСТОРОВ С МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ ЗАТВОРНЫМ УЗЛОМ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЯЧЕЕК/Бачурин В.В., Романовский С.М., Семешина И.П.//Патент на изобретение RU 2639579</p>
--	--

Заместитель генерального директора
АО «НПП «Пульсар»



Ю.В. Колковский